

177

IMPLANTAÇÃO DE BAIXA ENERGIA DE Sb EM CRISTAIS DE Si. *Mateus Dalponte, Joel P. de Souza (orientador)* (Laboratório de Microeletrônica, Instituto de Física, UFRGS).

Com o avanço da tecnologia, as dimensões dos dispositivos eletrônicos estão sendo reduzidas cada vez mais. Uma das técnicas utilizadas na fabricação desses dispositivos é a implantação iônica de baixa energia, que permite produzir perfis rasos de dopantes nos materiais semicondutores utilizados na eletrônica. Os experimentos realizados envolveram implantação de Sb em Si com energia de 20keV e etapas de recozimento rápido e convencional. O objetivo é analisar a qualidade da amostra e comparar os resultados obtidos nos diferentes processos. As amostras que passaram pelo recozimento rápido apresentaram maior qualidade nas análises realizadas, o que mostra maior eficácia deste tipo de recozimento sobre o convencional. A qualidade das amostras ficou abaixo do esperado, o que significa que é preciso fazer modificações nos processos para obtermos melhores resultados. Os experimentos continuarão sendo realizados com diferentes materiais e processos a fim de encontrarmos uma otimização. (Financiamento: CNPq).